(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2026 年 5 月 28 日 (28.05.2026)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2026/108700 A1

(51) 国际专利分类号:
G11C 8/14 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/134600

(22) 国际申请日: 2025 年 11 月 13 日 (13.11.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
202411689800.9 2024年11月22日 (22.11.2024) CN

(71) 申请人: 长鑫科技集团股份有限公司 (**CXMT CORPORATION**) [CN/CN]; 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号 230601 (CN)。

(72) 发明人: 张琪瑶 (**ZHANG, Qiyao**); 中国安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号 230601 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

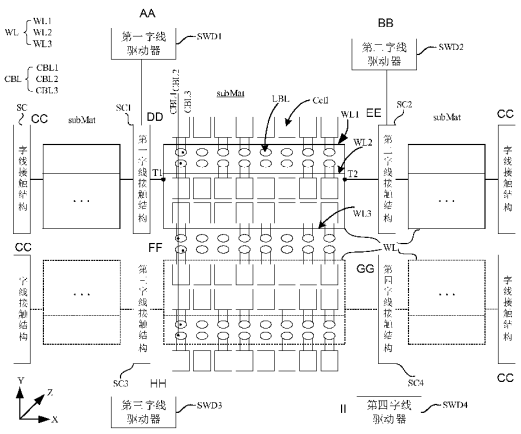
(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MU, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(54) **Title:** MEMORY

(54) 发明名称: 存储器

图 2



AA First word line driver
BB Second word line driver
CC Word line contact structure
DD First word line contact structure
EE Second word line contact structure
FF Third word line contact structure
GG Fourth word line contact structure
HH Third word line driver
II Fourth word line driver

(57) **Abstract:** Embodiments of the present disclosure provide a memory, comprising at least: a storage array, the storage array comprising a plurality of word lines; and word line contact structures, including a first word line contact structure and a second word line contact structure located on two opposite sides of the storage array, wherein the first word line contact structure is configured to be connected to a first word line driver, the second word line contact structure is configured to be connected to a second word line driver, and each word line in the storage array is simultaneously driven by the first word line driver and the second word line driver.

(57) 摘要: 本公开实施例提供一种存储器，至少可以包括：存储阵列，所述存储阵列包含多条字线；字线接触结构，包括位于所述存储阵列相对两侧的第一字线接触结构和第二字线接触结构，所述第一字线接触结构用于连接第一字线驱动器，所述第二字线接触结构用于连接第二字线驱动器，所述存储阵列中的每一条字线同时受到所述第一字线驱动器和所述第二字线驱动器的驱动。

WO 2026/108700 A1